ВАКАНСИИ В НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМАХ КАК ПРЕДПОСЫЛКА СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

А.А. Мамалуй, Т.Н. Шелест, О.Н. Андреева HTУ «ХПИ», Харьков, Украина

Создание надежных систем хранения и транспортировки водорода является одной из ключевых проблем развития водородной энергетики. Известно, что низкоразмерные системы (НРС), к числу которых относятся халькогениды переходных металлов, могут быть интеркалированы водородом. Рассматриваемое в настоящей работе соединение диселенида ниобия NbSe₂ обладает сильной анизотропией физических свойств, являющееся следствием слоистой структуры. Внедрение в межслойное пространство атомов и молекул (интеркалирование) открывает широкие перспективы для целенаправленного изменения их свойств.

Известно, что водород в NbSe₂ может занимать две неэквивалентные позиции, отличающиеся как положением в решетке, так и энергий внедрения и диффузии. Концентрация внутрислойного водорода значительно выше, чем межслойного, а энергия связи выше для внутрислойного. Введение водорода может существенно влиять на зонную структуру в результате переноса заряда от водорода в зону проводимости матрицы. При заполнении междоузлий атомами водорода возникают новые центры рассеяния, что ведет к возрастанию электросопротивления [1]. Температура ВЗП-перехода слабо падает с увеличением содержания водорода.

Интересной является перспектива интеркалирования водородом квазидвумерных монокристаллов $NbSe_2$ с вакансиями, так как в этом случае может быть интеркалирована большая концентрация водорода. Основными методами создания сравнительно заметной концентрации точечных дефектов (вакансий) являются облучение и высокотемпературный нагрев. Эти методы существенно отличаются.

Ранее авторами [2] изучено влияние вакансий селена на свойства NbSe₂. Создание вакансий в монокристаллах NbSe₂ осуществлялось с помощью дегазации атомов селена при изотермической выдержке образцов в области повышенных температур. Установлено, что создание вакансий существенно влияет на электросопротивление. При образовании вакансий селена происходит перераспределение носителей заряда по мере увеличения концентрации вакансий и, как следствие, ослабление связей Nb-Se и усилением связей Nb-Nb. Коме того, образование значительной концентрации вакансий может приводить к фазовому переходу 2H-NbSe₂ – 4H- NbSe₂ [3].

Список литературы:

- 1. Эксперирментальное исследование системы NbSe₂ водород: Препринт-277 / А.М. Оболенский, Х.Б. Чашка, В.И. Белецкий, А.В. Бастеев. – Харьков: ИПМаш АН УССР. – 1988. – 48 с.
- 2. Mamalui A.A., Shelest T.N., Fatyanova N.B., Sirenko V.A. The influence of point defects on the temperature dependence of quasi-two-dimensional 2H-NbSe₂ resistivity // Functional Materials. 2005. V.12, №3. C.521-525.
- 3. Андреева О.Н., Брауде И.С., Мамалуй А.А. Вакансии селена и их влияние на тонкую структуру квазидвумерного монокристалла NbSe₂ // Физика металлов и металловедение, 2012, т. 113, № 9. с. 1-6;